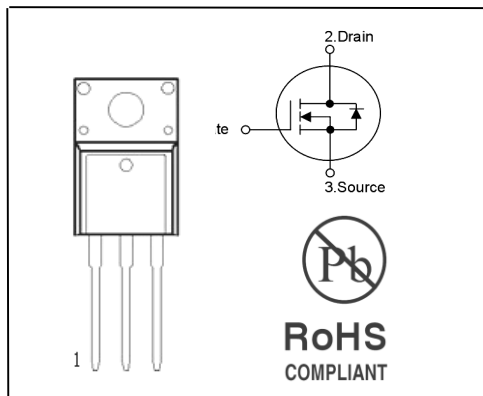


描述

FHF8N60为N沟道增强型高压功率MOS场效应管。该产品可广泛适用于AC-DC开关电源, DC-DC电源转换器, 高压H桥PMW马达驱动。

特点

- ★ 8A,600V,RDS(on)(典型值) 0.8Ω
- ★ 低电荷、低反向传输电容
- ★ 开关速度快



极限值 (Tc=25°C)

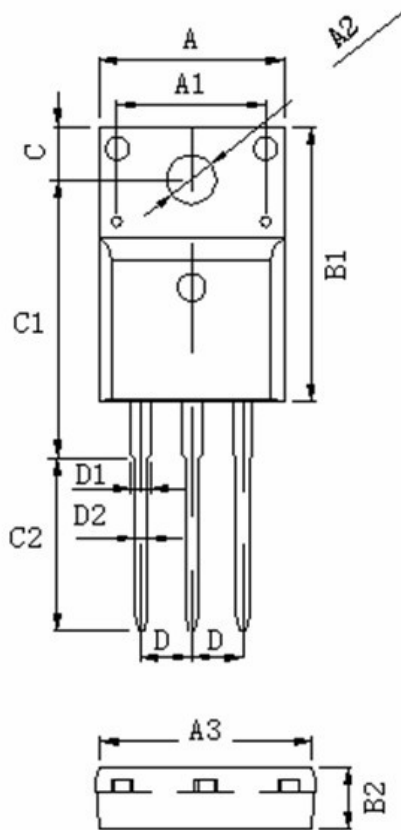
参数名称	符号	数值	单位
漏极—源极电压	VDSS	600	V
漏极电流	TC=25°C ID	8	A
栅源电压	VGS	±30	V
耗散功率	TC=25°C PD	52	W
结温	TJ	150	°C
储存温度	Tstg	-55~150	°C

特性参数值 (Tc=25°C)

参数说明	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
漏源反向电压	BVDSS	VGS=0V, ID=250μA	600	--	--	V
漏源截止电流	IDSS	VDS =600V, VGS= 0V	--	--	1.0	μA
栅源截止电流	IGSS	VGS = ±30V, VDS= 0V	--	--	±100	nA
通态电阻	RDS(on)	VGS=10V, ID=3.5A	--	0.8	1.2	Ω
栅-源极开启电压	VGS(th)	VDS = VGS, ID = 250μA	2.0	--	4.0	V
源漏二极管正向 导通电压	VFS	IS=7A, VGS=0V	--	--	1.4	V

封装外形

- ★ TO-220F
- ★ 图形尺寸



标注	毫米
A	10.03±0.20
A1	7.00±0.10
A2	3.12±0.10
A3	9.60±0.20
B1	15.75±0.20
B2	4.72±0.20
B3	6.60±0.20
C	3.20±0.10
C1	15.80±0.20
C2	9.90±0.2
D	典型值 2.54
D1	1.47(最大)
D2	0.80±0.10
E	2.55±0.20
E1	0.70±0.05
E2	1.00×45°
E3	0.50±0.10
E4	2.80±0.20